超高電圧応用に挑戦した1/3世紀 -核融合炉用中性粒子ビーム入射装置技術の進展-

2018年12月14日 (株)日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 核融合・加速器部 河上 浩幸

Innovating Healthcare, Embracing the Future

Contents

- 1. ITER-NBTFの実績と近況
 - •概要 現地状況 耐電圧試験
 - •課題克服 圧力容器、絶縁確保、電位固定
- 2. NBIの開発、製作の経緯
 - ・開発、製作の経緯・JT-60用NBI・LHD用NBI
- 3. ビーム技術の応用展開
 - ・ミリング装置 ・スパッタ装置 ・酸素イオン注入装置
 - ・粒子線がん治療装置
- 4. まとめ

1. ITER-NBTFの実績と近況 (1)概要

HITACHI Inspire the Next

ITER用NBI(中性粒子入射装置)では、DC-1MV超高電圧電源を用いて負イオンを加速し、 1MeV、40A、1時間の負イオンビームを発生させる。 ITERに先駆けてビーム加速技術の実証を目的として、イタリア・パドバにNBTFが建設中。 直流発生器以降の高電圧部主要機器(桃色)を日本が担当する。 JT-60U(DC-500kV)の納入実績を遥かに超えるDC-1MV超高電圧電源を製作。



2

HITACHI

Inspire the Next

1. ITER-NBTFの実績と近況 (2) 現地状況

2012年に受注、約5年かけて計16台の機器製作を完遂。 現地据付は、DCG~トランスミッションライン3のタンク18迄は据付が完了、耐電圧試験を開始。





【TL1のタンク(地下ピット設置)】



© Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

3

ITER/BA成果報告会2018 核融合エネルギーフォーラム

1. ITER-NBTFの実績と近況(3) 耐電圧試験

HITACHI Inspire the Next

RFX研にてITERの他機器に先駆け、受け入れ試験を開始した。 TPS(試験用電源)を使用した耐電圧試験を2回実施し、合格した。今後、3回実施予定。 ①第1回目(9/12~13)DCフィルタ~直流発生器(DCG)1-5

・耐電試験電圧の内容

DC-1200kVで1時間、DC-1060kVで5時間、DC-1060~-1265kVの繰り返し試験(5回) ②第2回目(11/12)トランスミッションライン1~2~3、HVD2(高電位デッキ2)

・耐電試験電圧の内容 DC-1200kVで1時間





<u>2回目の耐電圧試験時</u>

ITER/BA成果報告会2018 核融合エネルギーフォーラム

HITACHI

1. ITER-NBTFの実績と近況(4)課題克服 ①圧力容器



1. ITER-NBTFの実績と近況(4)課題克服(2)絶縁確保

■電界集中を見逃し、DCフィルタにて絶縁破壊が発生

- ・機能:整流後の電圧リップルの低減
- ・構造:限定された空間に200~1000kV電位の抵抗やコンデンサ等の多数の部品を搭載



- ◇原因:放電端は、並列抵抗の電極(0V電位:ユニット電位)に取付けられたワッシャのエッジ。 当該ワッシャ(M4)は外径φ10mmと小径であり電界集中度が高く、加えてナット最外径 (φ8.1mm)より突出している為、過度な電界集中が発生。
- ◇対策:ワッシャエッジ部の電界集中を解消する為、ボルト材質を樹脂(PEEK材)に変更(対象列)。 直列抵抗のボルトも同様に、樹脂に変更。

6

1. ITER-NBTFの実績と近況(4)課題克服 ③電位差発生 HITACHI Inspire the Next

■HVD2(高電位デッキ2)の過渡的な電位差の対策

- ・機能:水、ガス、温水を絶縁配管で200~1000kV電位に供給
- ・構造:円筒型の圧力容器内に、絶縁配管(各電位で3本~11本)と金属配管とで構成
- ◇ 配管系の浮遊C成分によって、電圧上昇の時定数が異なり、電位差が発生。



[©] Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

2. NBIの開発、製作の経緯(1)

HITACHI Inspire the Next

日立は1978年にJT-60原型ユニットの詳細設計を始めとし、ヘリオトロンE、JT-60、 LHD用NBIを製作、2017年のNBTF用NBIの納入に至る。



入射パワーの遍歴

製作年

図 NBIの入射パワー遍歴(設計時)

2. NBIの開発、製作の経緯(2)JT-60用NBI

HITACHI Inspire the Next

■ JT-60用として、1986年に正イオン源を搭載したNBIを14機、1992年にT-NBIを2機納入
 ■ JT-60U用として、1995年に負イオン源を搭載したN-NBIを1機納入



正イオン源を搭載したNBIの外観

N-NBIの主な仕様(設計時)
 ・ビームエネルギー : 500 keV
 ・入射エネルギー : 10 MW

 (1ビームライン当たり)

 ・イオン種 : H⁺ / D⁻
 ・イオン源数 : 2台

 (1ビームライン当たり)

*写真は量子科学技術研究開発機構殿より御提供

<u>T-NBI及びN-NBIの外観</u>



2. NBIの開発、製作の経緯(3)LHD用NBI

ITER/BA成果報告会2018 核融合エネルギーフォーラム



■ LHD用として、1998年に負イオン源を搭載したNBIの2号機、2001年に3号機を納入 ■ LHD用として、2005年に正イオン源を搭載したNBIの4号機、2010年に5号機を納入





LHD用 NBI2号機及び3号機の外観

■ LHD用負イオン源NBIの主な仕様(設計時)
 ・ビームエネルギー : 180 keV
 ・入射エネルギー : 5MW(H⁻)

(1ビームライン当たり)
: H⁻ / D⁻
<li: 2台

(1ビームライン当たり)







<u>LHD用のNBI4号機の外観</u>

*写真は核融合科学研究所殿より御提供

・イオン種

・イオン源数

3.ビーム技術の応用展開 (1)イオンビームミリング装置 HITACHI Inspire the Next

〔特徴:大口径(φ580mm)バケット型イオン源、磁気ヘッドの製造装置用〕

■イオンビームミリングの原理 大口径バケット型イオン源からイオンビームを基板 に打ち込み、基板の粒子を叩き出して基板を削る。





<u>ミリングの加工例</u>



■大口径バケット型イオン



バケット型イオン源の外観

*写真、図は(株)日立ハイテクノロジーズ殿及びワイエイシイビーム(株)殿より御提供

■<u>イオンビームミリング装置の外観</u>



3.ビーム技術の応用展開(2)イオンビームスパッタ装置

〔特徴:複合機能のスパッタ装置、研究成膜装置用〕

■イオンビームスパッタの原理 バケット型イオン源から引き出したイオンビームを、 ターゲットに打ち込み、ターゲットでスパッタされた 粒子が基板に付着する。





■多元同時イオンビームスパッタ装置の外観及び主な仕様



ITER/BA成果報告会2018 核融合エネルギーフォーラム

3.ビーム技術の応用展開(3) SIMOXウェーハ用酸素イオン注入装置 HITACHI Inspire the Next

[特徴:大電流(Max100mA)の酸素イオンビーム、半導体ウェハー製造用]

■ SOIウェーハの作製法 SOI: <u>Silicon on I</u>nsulator



SIMOX : Separation by Implanted Oxygen

酸素イオン注入装置の外観

LSIの高速化、低消費電力化が目的



酸素イオン注入装置の構成 注入エネルギー(Max240kV)



イオンビーム Max100mA © Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

3.ビーム技術の応用展開(4)粒子線がん治療装置

HITACHI **Inspire the Next**

[特徴:メンテが容易な高信頼性イオン源、医療用]



4. まとめ

HITACHI Inspire the Next

- (1)NBTFの現地据付工事及び耐電圧試験の進展 RFX研設とQST殿の協働により、現地据付工事及び耐電圧試験は順調に進んで いる。日立はTA (テクニカルアドバイザ)を派遣し、据付工事、耐電圧試験を助勢。
 (2) NBIの開発、製作の実績及びITER計画への展開 1978年のJT-60用原型ユニットの詳細設計を始めとして、ヘリオトロンE用、JT-60 原型ユニット用、JT-60用、JT-60U用(T-NBI、N-NBI)、LHD用(2~5号機)、ITER用 NBTFと30年以上にわたり、開発、製作を実施。
 (3) ビーム技術の応用展開
 - NBI装置開発から派生したイオン源を主体としたビーム技術を産業用装置へ展開。 ⇒日立は、今後も核融合開発に貢献していきます。



ITER/BA成果報告会2018 核融合エネルギーフォーラム

Innovating Healthcare, Embracing the Future

ITER/BA成果報告会2018 核融合エネルギーフォーラム

HITACHI Inspire the Next